## STMを用いた多価イオン照射後のグラファイト表面の観察 電子物性工学科 大谷研究室 中島 寿明

1.序論



本研究では多価イオンを個体表面に照射する装置を製作し、新しく 導入した走査型トンネル顕微鏡(STM)を用いて照射後の表面原子構造 を観察することを目的とした。

2.1 ビームライン



図2にビームラインの概略を示す。EBIT(Electron Beam Ion Trap)から引き出されたイオンをまずディフレクター1によって方向 づけをする。次に3つのアインツェルレンズでビームの発散を抑える。 ベンダーは垂直方向のビームを水平方向に曲げるのに使われる。可動 式のアパーチャーはイオンビームの形状を測定するために使用される。 加速レンズはここではアインツェルレンズと同様の動作をし、次の四 重極レンズによって価数分析器の入口スリットを通過するビーム強度

が最大となるように、ビーム形状の調整を行う。価数分析器により選別された多価イオンは、出口スリット通過後減速レンズにより減速され、照射チェンバーへ運ばれる。イオンを減速するのは、異なる価数のイオンの運動エネルギーを揃えるためである。照射チェンバーはビームラインと絶縁されており高電圧を印加し、減速レンズを調整することによって、イオンビームの発散を抑えた。以上の光学系を配置し、実際にイオンビームを観測した結果、500×q eVまで減速可能であることを確認した。

2.2 多価イオン照射装置

図3に照射装置を示す。多価イオン源の限られた運転時間の中で試 料交換を可能にするため、ビームラインの真空を破らずにサンプル交 換の出来る機構にした。製作したサンプルホルダーと、試料交換の手 順を図4に示す。この図から分かる通り、サンプルホルダーは可動式 になっているので、イオンビームがサンプルに当たるようイオンビー ムの位置を確認する必要がある。そこで、サンプルホルダーはサンプ ルと対応する位置に小孔を空けて、通過するビームを観測出来るよう にした。



## 3.1 STMの動作原理

STMの動作原理について簡単に説明する。図5のように金属探針を 1nm程度、導電性試料に近付けるとトンネル電流が流れる。定電流 測定では、トンネル電流が一定になるようにサーボ回路によりZ圧電 体にフィードバックをかける。X,Y圧電体には走査電圧をかけて、探 針を試料表面に沿って波線のように走査するとSTM像が得られる。 また、定高度測定では針の高さを一定に保ちつつ水平に走査しながら 試料表面との微少な距離変化を電流値の増減として測定する。凹んだ部分では試料と探針の距離が離れ電流値が減少し、一方、山の部分では電流値が増加するため、表面の凹凸がわかる。

3.2 照射試料の原子構造 照射試料となるグラファ イトの原子構造を図6に示 す。炭素原子は共宿合に より六方格子構造ファンデ ルワールス力による者の になっている。こ の結合に寄している。こ ルミ面によっている。こ ルミのによっている。こ に いこのにしているので、 の電子にしているので、 に しているので、 の電く見えるようになっているので、



く、 は暗く見えるようになる。実際に得られたSTM像を図7示す。 白く見えているのが である。





\_次元像



三次元像 図7

## 4.多価イオン照射後のグラファイト表面の観察

グラファイト表面に33価,16.5keVのKrイオンを照射し、その試料 をSTMで観察した。照射した部分を確認し、その電流変化を見た像

を図8に示す。照射した部分の電流値が著し く変化しているのが分かる。 図8のA線での 電流変化と探針の高度変化を図9示す。図よ り、探針の動作距離の高低差が20 程度あ るのが分かる。ただし、STMの動作原理を 考えると、STM像の隆起が結晶構造の隆起 であるかどうかは未解明である。

図 9



188 Å



A線での電流変化





二次元像

A線での高度変化

図 8

## 5.まとめと今後の展望

雑音の除去、適当な探針を製作し、STMによるグラファイト表面 のSTM像を得る事が出来た。また、多価イオン源の限られた運転時 間の中でビームラインの真空を破らずに試料交換が可能な照射装置を 製作し、ビームラインに減速レンズ、ディフレクターを設置すること により、500×qeVまで減速可能であることを確認した。しかし、多 価イオン照射後のグラファイトの表面原子構造を定量的に比較、検証 をするまでには到らなかった。

今後の展望としては、多価イオン照射後のグラファイトの表面原子 構造を引き続き観察し、価数、入射エネルギーの違いによる構造変化 を比較する。他の試料に関しても、今後、同様の観察を継続する。